

СОДЕРЖАНИЕ

Том 47, номер 2, 2018

КВАНТОВЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ

Генерация и концентрирование терагерцевого излучения в микрорезонаторе с открытой квантовой точкой

А. В. Цуканов, И. Ю. Катеев

93

ПЛАЗМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Электрофизические параметры и спектры излучения плазмы трихлорида бора

Д. Б. Мурин, А. В. Дунаев

106

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ МИКРО- И НАНОЭЛЕКТРОНИКИ

Автоэмиссионные свойства наноструктурированных кремниевых катодных матриц

Р. К. Яфаров, С. Ю. Суздальцев, В. Я. Шаныгин

115

Влияние технологических режимов на электрофизические свойства пленок легированного полиакрилонитрила частицами металлов

Т. А. Бедная, С. П. Коноваленко

124

Атомно-слоевое осаждение нитрида алюминия с использованием трис(диэтиламино)алюминия и гидразина или аммиака

А. И. Абдулагатов, Ш. М. Рамазанов, Р. С. Даллаев, Э. К. Мурлиев, Д. К. Палчаев,

М. Х. Рабаданов, И. М. Абдулагатов

131

ПРИБОРЫ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ

Инфракрасные детекторы с барьером Шоттки, чувствительные к излучению с энергией квантов больше высоты потенциального барьера

Э. А. Керимов, Н. Ф. Казымов, С. Н. Мусаева

146

Частотные характеристики нитрид-галлиевых полевых транзисторов с ловушками в барьерном слое

А. Н. Алёшин, Н. В. Зенченко, Д. С. Пономарев, О. А. Рубан

153

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ

Элемент совпадения на основе ячейки памяти STG DICE для ассоциативных запоминающих устройств, сбоеустойчивых к воздействиям одиночных ядерных частиц

Ю. В. Катунин, В. Я. Стенин

158

Вниманию авторов

175
